

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4133350号  
(P4133350)

(45) 発行日 平成20年8月13日(2008.8.13)

(24) 登録日 平成20年6月6日(2008.6.6)

(51) Int.Cl.	F I
HO 1 L 29/78 (2006.01)	HO 1 L 29/78 6 5 3 A
HO 1 L 29/739 (2006.01)	HO 1 L 29/78 6 5 5 B

請求項の数 5 (全 13 頁)

(21) 出願番号	特願2003-3414 (P2003-3414)	(73) 特許権者	000003609
(22) 出願日	平成15年1月9日(2003.1.9)		株式会社豊田中央研究所
(65) 公開番号	特開2004-221126 (P2004-221126A)		愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道4 1
(43) 公開日	平成16年8月5日(2004.8.5)		番地の1
審査請求日	平成17年7月26日(2005.7.26)	(73) 特許権者	000003207
			トヨタ自動車株式会社
			愛知県豊田市トヨタ町1番地
		(74) 代理人	110000110
			特許業務法人快友国際特許事務所
		(72) 発明者	河路 佐智子
			愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道4 1
			番地の1 株式会社豊田中央研究所内
		(72) 発明者	石子 雅康
			愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道4 1
			番地の1 株式会社豊田中央研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置とその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

パイボアで動作する縦型の半導体装置であって、  
表面にトレンチが形成された半導体部と、トレンチの壁面に沿って形成されたゲート絶縁膜と、トレンチ内に形成されたゲート電極を備え、  
前記半導体部は、  
裏面に形成されているとともに、一方の主電極に電氣的に接続する第1導電型の第1半導体領域と、  
その第1半導体領域上に形成されている第2導電型の第2半導体領域と、  
その第2半導体領域上に形成されており、前記トレンチの側面に接しているとともに他  
方の主電極に電氣的に接続する第1導電型の第3半導体領域と、  
その第3半導体領域上に形成されており、前記トレンチの側面に接しているとともに前  
記他方の主電極に電氣的に接続する第2導電型の第4半導体領域と、  
前記トレンチの底面の一部が前記半導体部の表面側に窪んでおり、その窪み内に位置す  
る領域と、を有する半導体装置。

【請求項 2】

前記半導体部は、1つのトレンチについて前記窪み内に位置する領域を複数有する請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記窪み内に位置する領域は、第2導電型領域を有する請求項1又は2に記載の半導体

10

20

装置。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の半導体装置を製造する方法であり、  
半導体部のトレンチ形成予定領域上の一部に犠牲層を形成する工程と、  
前記犠牲層と前記犠牲層が形成されていないトレンチ形成予定領域の前記半導体部をエッチングし、前記犠牲層が除去された後にも前記トレンチ形成予定領域の半導体部をさらにエッチングして半導体部にトレンチを形成する工程を有する半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の半導体装置を製造する方法であり、  
半導体部のトレンチ形成予定領域上に、エッチャントに対するエッチング速度が異なる複数種の犠牲層を形成する工程と、

前記犠牲層をエッチングし、前記犠牲層が除去された後にも前記トレンチ形成予定領域の半導体部をさらにエッチングして半導体部にトレンチを形成する工程を有する半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体装置とその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

特許文献 1 には、図 15 に示すように、 $n^-$ 型ドリフト領域 928 と  $p$  型ボディ領域 930 の間に  $n$  型領域 929 が形成された絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（以下「IGBT」という）が示されている。この  $n$  型領域 929 は、 $n^-$ 型ドリフト領域 928 よりも不純物濃度が高い。

【0003】

上記 IGBT がオンすると、 $p^+$ 型コレクタ領域 924 から  $n^+$ 型バッファ領域 926 を経由して、 $n^-$ 型ドリフト領域 928 にホールが流入する。このホールは、上記  $n$  型領域 929 によって  $p$  型ボディ領域 930 への移動が抑制される。この結果、 $n^-$ 型ドリフト領域 928 と上記  $n$  型領域 929 の境界近傍の  $n^-$ 型ドリフト領域 928 にホールが蓄積される。これにより、 $n^-$ 型ドリフト領域 928 のキャリア分布が  $n^+$ 型エミッタ領域 932 に近い側で少なくならず、従来の IGBT に比較してオン電圧を低減できる旨が特許文献 1 に記載されている。

【0004】

【特許文献 1】

特開平 8 - 316479 号公報（その公報の図 16 参照）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、半導体装置のオン電圧を低減できる新規な技術を提供することを課題とする。

【0006】

【課題を解決するための手段及び作用と効果】

本発明の 1 つの態様のバイポーラで動作する縦型の半導体装置は、表面にトレンチが形成された半導体部と、トレンチの壁面に沿って形成されたゲート絶縁膜と、トレンチ内に形成されたゲート電極を備えている。半導体部は、第 1 導電型の第 1 半導体領域と、第 2 導電型の第 2 半導体領域と、第 1 導電型の第 3 半導体領域と、第 2 導電型の第 4 半導体領域を備えている。第 1 半導体領域は、半導体部の裏面に形成されているとともに、一方の主電極に電氣的に接続する。第 2 半導体領域は、第 1 半導体領域上に形成されている。第 3 半導体領域は、第 2 半導体領域上に形成されており、トレンチの側面に接しているとともに他方の主電極に電氣的に接続する。第 4 半導体領域は、第 3 半導体領域上に形成されており、トレンチの側面に接しているとともに他方の主電極に電氣的に接続する。半導体部はさらに、トレンチの底面の一部が半導体部の表面側に窪んでいる窪み内に位置する領域

10

20

30

40

50

(以下では「窪み内領域」という)を備えている。

この態様のように、半導体部が上記窪み内領域を有する場合、オン時にはその窪み内領域にキャリアを溜めることができる。よって、オン時に半導体部に存在するキャリアを増加させることができる。このため、半導体装置のオン電圧を低減できる。

【0007】

【発明の実施の形態】

本発明の好ましい態様や、他の態様等を以下に示す。

本発明は、オン時に第1導電型キャリアと第2導電型キャリアが流れるバイポーラ型半導体装置に適用することが好ましい。この態様によると、オン電圧を効果的に低減できる。この中でも、半導体部が、第1導電型の第1半導体領域と、第2導電型の第2半導体領域と、第1導電型の第3半導体領域と、第2導電型の第4半導体領域を有することが好ましい。第3半導体領域は、トレンチに隣合っていることが好ましい。別の表現をすると、第3半導体領域は、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に隣合っていることが好ましい。そして、オン時には、第1導電型キャリアが第1半導体領域、第2半導体領域、第3半導体領域の順に流れることが好ましい。また、オン時には、第2導電型キャリアが第4半導体領域、第3半導体領域、第2半導体領域、第1半導体領域の順に流れることが好ましい。上記構造のバイポーラ型半導体装置としては、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)や、MOSゲート型サイリスタ等が挙げられる。

【0008】

上記構造の場合は、窪み内領域に第1導電型キャリアを溜めることができる。上記構造の場合、窪み内領域は第2導電型領域を有することが好ましい。このように、窪み内領域は、溜められるキャリアと逆導電型の領域を有することが好ましい。この第2導電型領域の不純物濃度は、上記した第2導電型の第2半導体領域の不純物濃度よりも高いことが好ましい。窪み内領域の不純物濃度は、 $1 \times 10^{14} \sim 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ であることが好ましい。これらの態様によると、窪み内領域にキャリアをより溜め易くすることができる。

【0009】

トレンチ底面は、トレンチ側に孔状に窪んでいることが好ましい。あるいは、トレンチ底面は、トレンチ側に段差状に窪んでいてもよい。

窪み内領域は、トレンチ下方に位置する半導体部からトレンチ側に(1)盛り上がっていてもよいし、(2)突出していてもよい。窪み内領域は、凸状に形成されていてもよい。窪み内領域は、直方体状や曲面体状等に形成されていてもよい。

【0010】

窪み内領域は、1つのトレンチに対して複数形成されていることが好ましい。この態様によると、窪み内領域にキャリアをより溜め易くすることができる。複数の窪み内領域の形状や大きさは等しくてもよいし、異なってもよい。

窪み内領域の高さは、トレンチの深さの1/10以上であることが好ましく、トレンチの深さの1/5以上であることがより好ましい。窪み内領域の高さは、トレンチの深さの3/4以下であることが好ましい。この態様によると、窪み内領域にキャリアがより溜まり易い。

【0011】

他の態様の半導体装置は、「トレンチの底面に沿ったゲート絶縁膜」がトレンチ側に窪んでおり、半導体部は、前記窪み内に位置する領域を有する。他の態様の半導体装置は、「トレンチ下方に位置する半導体部」がトレンチ側に(1)盛り上がっている、又は(2)突出している。他の態様の半導体装置は、「トレンチの底部」又は「トレンチ底面に隣接する半導体部」が凹凸形状となっている。好ましくは、奥行方向に沿って凹凸形状となっていることがよい。奥行方向に沿っていると、凹凸形状を形成し易い。

【0012】

他の態様の半導体装置の製造方法は、半導体部のトレンチ形成予定領域上に犠牲層を形成する工程と、犠牲層と半導体部をエッチングして半導体部にトレンチを形成する工程を

10

20

30

40

50

有する。さらに、トレンチの壁面に沿ってゲート絶縁膜を形成する工程や、トレンチ内にゲート電極を形成する工程を有していてもよい。前記犠牲層を形成する工程は、半導体部のトレンチ形成予定領域の一部上に犠牲層を形成する工程であることが好ましい。この場合、トレンチを形成する工程では、犠牲層と、犠牲層が形成されていないトレンチ形成予定領域の半導体部をエッチングし、犠牲層が除去された後にもトレンチ形成予定領域の半導体部をさらにエッチングする。あるいは、前記犠牲層を形成する工程は、半導体部のトレンチ形成予定領域上に所定のエッチャント（エッチング液、エッチングガスの両方を含む）に対するエッチング速度が異なる複数種の犠牲層を形成する工程であることが好ましい。この場合、トレンチを形成する工程では、犠牲層をエッチングし、犠牲層が除去された後にもトレンチ形成予定領域の半導体部をさらにエッチングして半導体部にトレンチを形成する。これらの態様によると、底面が窪んだトレンチを1回のエッチングで形成できる。

10

#### 【0013】

他の態様の半導体装置の製造方法は、半導体部の一部上に第1マスクを形成する工程と、第1マスクで覆われた半導体部を第1エッチングする工程と、第1エッチングにより露出した半導体部の一部上に第2マスクを形成する工程と、第1マスクと第2マスクで覆われた半導体部を第2エッチングする工程を有する。この態様によっても、底面が窪んだトレンチを形成できる。

#### 【0014】

##### 【実施例】

20

図1は、第1実施例の半導体装置の平面図の一部を示す。図2は、図1のA-A線断面図を示す。図3は、図1のB-B線断面図を示す。図4は、図1のC-C線断面図を示す。図4を参照するとわかるように、図3はトレンチ34の底が深い部分での断面図である。図4はトレンチ34の底が浅い部分での断面図である。なお、本明細書では、図1の縦方向を「幅方向」、横方向を「奥行方向」、紙面垂直方向を「深さ方向」という。

#### 【0015】

図1に示すように、この半導体装置は、奥行方向に沿ってストライプ状に伸びるトレンチ34が幅方向に複数形成されている。図1のA-A線断面図である図2に示すように、この半導体装置は、半導体部22を備えている。半導体部22は、半導体装置を絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（以下「IGBT」という）として機能させるための構造を有する。具体的には、半導体部22は、 $p^+$ 型コレクタ領域24と、これに接する $n^+$ 型バッファ領域26と、これに接する $n^-$ 型ドリフト領域28と、これに接する $p$ 型ボディ領域30と、これに接する $n^+$ 型エミッタ領域32等を有する。半導体部22には、上記各領域24、26、28、30、32が奥行方向に連続して形成されている。

30

#### 【0016】

なお、トレンチ34のパターンは図1に示すような各トレンチ34が別個に区切られたストライプ状に限定されず、様々なパターンを採用できる。例えば、各トレンチ34がつながっているパターン（トレンチ34がチェック状や網の目状のパターン等）であってもよい。

#### 【0017】

40

図2に示すように、トレンチ34は、半導体部22に形成されている。トレンチ34の壁面に沿ってゲート絶縁膜36が形成されている。トレンチ34内にはゲート電極38が形成されている。図1のC-C線断面図である図4に示すように、ゲート電極38は、トレンチ34外に位置するゲート引出し部39につながっている（連続的に形成されている）。ゲート電極38やゲート引出し部39はポリシリコンや、金属等の導電体によって形成すればよい。図4に示すように、ゲート電極38上には、層間絶縁膜42が形成されている。層間絶縁膜42には、コンタクトホール43が形成されている。層間絶縁膜42上には、ゲート配線層44が形成されている。ゲート配線層44は、アルミニウムや銅等の金属等の導電体によって形成すればよい。ゲート配線層44の一部はコンタクトホール43に入り込んでいる。コンタクトホール43内のゲート配線層44の底面はゲート引出し部

50

３９に接している。これにより、ゲート配線層４４と、ゲート引出し部３９及びゲート電極３８は電氣的に接続されている。

【００１８】

図２に示すように、 $p^+$ 型コレクタ領域２４の底面には、コレクタ電極２０が接している。 $n^+$ 型エミッタ領域３２と $p$ 型ボディ領域３０（詳細にはボディコンタクト領域）の頂面には、エミッタ電極４０が接している。

【００１９】

図４に示すように、トレンチ３４の底面は、トレンチ３４側に孔状に窪んでいる。トレンチ３４の底面には、この窪みが複数形成されている。半導体部２２は、その窪み内に位置する領域（窪み内領域）４６を有する。窪み内領域４６は、複数形成されている。各窪み内領域４６は $n$ 型領域となっている。各窪み内領域４６は、 $n^-$ 型ドリフト領域２８の不純物濃度よりも高い。本実施例では、窪み内領域４６の不純物濃度は、約 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ である。本実施例では、窪み内領域４６の高さは、トレンチ３４の深さの約 $1/4 \sim 1/3$ となっている。各窪み内領域４６は、トレンチ３４の幅方向（図４の紙面垂直方向）に沿って伸びている。各窪み内領域４６は、トレンチ３４の奥行方向に沿って間欠的に形成されている。各窪み内領域４６の頂面と２つの側面は、ゲート絶縁膜３６によって覆われている。これら２つの側面は、トレンチ３４の幅方向に伸びている。

【００２０】

第１実施例の半導体装置の動作を説明する。図２に示すように、エミッタ電極４０を接地した状態でゲート電極３８とコレクタ電極２０に正電圧を印加する。これにより、 $I_{GBT}$ をオンさせる。すると、ゲート電極３８にゲート絶縁膜３６を介して隣合う $p$ 型ボディ領域３０に $n$ 型チャネルが形成される。この結果、エレクトロンが $n^+$ 型エミッタ領域３２から、 $n$ 型チャネル、 $n^-$ 型ドリフト領域２８、 $n^+$ 型バッファ領域２６を通して $p^+$ 型コレクタ領域２４に流入する。また、ホールが $p^+$ 型コレクタ領域２４から、 $n^+$ 型バッファ領域２６、 $n^-$ 型ドリフト領域２８を通して、 $p$ 型ボディ領域３０（ $p$ 型ボディコンタクト領域）に流入する。

【００２１】

第１実施例の半導体装置では、図４に示すように、トレンチ３４の底面がトレンチ３４側に窪んでいる。半導体部２２は、その窪み内に位置する領域（窪み内領域）４６を有する。この窪み内領域４６の側面と頂面はゲート絶縁膜３６によって覆われている。よって、この窪み内領域４６に流れ込んだホールは、ゲート絶縁膜３６の壁によってこの窪み内領域４６外への移動が抑制される。このため、半導体部２２を流れるホールは、この窪み内領域４６に溜められる。この窪み内領域４６に溜められたホールの存在が、図２に示す $n^+$ 型エミッタ領域３２からのエレクトロンの流入を促進する働きをすることができる。このため、オン電圧を低減できる。

【００２２】

図１５に示す従来の半導体装置では、 $p$ 型ボディ領域９３０の底面と $n^-$ 型ドリフト領域９２８の頂面の間全体に $n$ 型領域９２９を介在させている。この構造の場合、 $n^-$ 型ドリフト領域９２８と $n$ 型領域９２９の境界付近にホールが蓄積されると、 $p^+$ 型コレクタ領域９２４、 $n$ 型領域群９２６、９２８、９２９、 $p$ 型ボディ領域９３０、 $n^+$ 型エミッタ領域９３２で構成される $pnpn$ 構造の寄生サイリスタがオンし易い（ラッチアップし易い）という問題があった。

これに対し、第１実施例の半導体装置では、図２に示すように、 $p$ 型ボディ領域３０の底面と $n^-$ 型ドリフト領域２８の頂面の間には $n$ 型領域が設けられていない。第１実施例の半導体装置は、図４に示すトレンチ３４の底面の窪み内に位置する窪み内領域４６にホールを溜めるものである。よって、図１５に示す従来の半導体装置とは異なり、寄生サイリスタがオンしにくい。

【００２３】

第１実施例の半導体装置の構造は、チップの中でもチップ周辺部に設けることが好ましい

10

20

30

40

50

。チップ周辺部は熱が溜まりにくいので、寄生サイリスタがよりオンしにくくなる。但し、チップ中央部を含むチップ全体に設けても勿論よい

【0024】

また、図15に示す従来の半導体装置では、p型ボディ領域930の底面とn<sup>-</sup>型ドリフト領域928の頂面の間全体にn型領域929を介在させている。即ち、p型ボディ領域930とn型領域929が直接に接している。このn型領域929はn<sup>-</sup>型ドリフト領域928よりも不純物濃度が高い。よって、このようなn型領域929が存在せず、p型ボディ領域930の底面とn<sup>-</sup>型ドリフト領域928の頂面が直接に接している構造に比べて空乏層が伸びにくい。このため、耐圧が低下するという問題があった。

これに対し、第1実施例の半導体装置では、図2に示すように、p型ボディ領域30の底面とn<sup>-</sup>型ドリフト領域28の頂面が直接に接している。よって、n<sup>-</sup>型ドリフト領域28側に空乏層が伸びやすい。このため、高耐圧を保持できる。

【0025】

また、図3に示すようにトレンチ34の底が浅い部分では、トレンチ34の底面は、p型ボディ領域30の底面よりも浅い位置にある。この構造によると、トレンチ34の底面がp型ボディ領域30の底面よりも深い位置にある場合に比べて、ゲート絶縁膜36へのコレクタ電圧の影響を小さくできる。特に、相対的に絶縁破壊が生じ易いトレンチ34の下側コーナー部に位置するゲート絶縁膜36a(図3参照)へのコレクタ電圧の影響を小さくできる。よって、ゲート絶縁膜36の絶縁破壊を生じにくくすることができる。このため、耐圧を上昇させることができる。

また、第1実施例の半導体装置によると、図3に示すn型の窪み内領域46とp型ボディ領域30の接合部からも空乏層を伸ばすことができる。よって、耐圧をより上昇させることができる。

【0026】

次に、第1実施例の半導体装置の第1製造方法について説明する。まず、図5に示すような半導体部22を形成する。半導体部22の形成方法としては種々の方法があり、公知の方法を採用できる。例えば、p型半導体基板24上に、n<sup>+</sup>型エピタキシャル層26、n<sup>-</sup>型エピタキシャル層28を順に成長させ、p型領域30をイオン注入によって作製する方法が挙げられる。次に、半導体部22のうち、トレンチ34を形成しない領域上にマスク50を形成する。また、半導体部22のうち、浅いトレンチを形成する領域上に厚さL1[μm]の犠牲層51を形成する。

【0027】

所定のエッチャントは、半導体部22(例えばシリコン)をエッチング可能である。このエッチャントは、マスク50はほとんどエッチングしない。このエッチャントは、犠牲層51をエッチング可能である。本実施例では、所定のエッチャントによる半導体部22のエッチング速度V2と犠牲層51のエッチング速度V1の比(エッチング選択比)V2/V1がL2/L1となるように各材料(エッチャント、半導体部22、犠牲層51)が選択されている。この場合、犠牲層51が例えばL1[μm]エッチングされると、半導体部22がL2[μm]エッチングされる。

【0028】

エッチャントとして例えば、HBrとNF<sub>3</sub>とO<sub>2</sub>を所定の混合比で混合したエッチングガスを用いると、シリコンとシリコン酸化膜のエッチング選択比をL2/L1に調整できる。エッチャントとして、SF<sub>6</sub>とO<sub>2</sub>を所定の混合比で混合したエッチングガスを用いる場合も同様である。また、これらのエッチングガスは、窒化膜(SiN)はほとんどエッチングしない。よって、これらのエッチングガスを用いる場合、半導体部22をシリコンで形成し、マスク50を窒化膜で形成し、犠牲層51をシリコン酸化膜で形成するとよい。なお、マスク50は酸窒化膜で形成してもよい。エッチャント、マスク50、犠牲層51として他の材料を用いることができるのは勿論である。また、半導体部22のうち、深いトレンチを形成する領域上には何も形成しない。即ち、半導体部22のうち、深いトレンチを形成する領域は露出させておく。

## 【 0 0 2 9 】

次に、R I E (Reactive Ion Etching) 等によってエッチングを行う。すると、図 6 に示すように、厚さ  $L_1$  [  $\mu m$  ] の犠牲層 5 1 がエッチングされる間に、半導体部 2 2 は  $L_2$  [  $\mu m$  ] エッチングされる。この状態では、犠牲層 5 1 が除去されるため、半導体部 2 2 のうち犠牲層 5 1 の下方に位置する領域が露出する。この状態から、さらにエッチングを継続する。すると、マスク 5 0 で覆われていない部分の半導体部 2 2 がさらに除去される。

これにより、半導体部 2 2 には、図 7 に示すように、底面が窪んだトレンチ 3 4 が形成される。本実施例の場合、底の深い部分と浅い部分を有するトレンチ 3 4 が形成される。トレンチ 3 4 の下方に位置する半導体部 2 2 は、その窪み内に位置する領域 ( 窪み内領域 ) 4 6 を有する。この窪み内領域 4 6 のうち上部と中間部は p 型領域となっている。窪み内領域 4 6 のうち下部は n 型領域となっている。

10

## 【 0 0 3 0 】

次に、この窪み内領域 4 6 に、n 型不純物をイオン注入する。すると、図 8 に示すように、この窪み内領域 4 6 の上部と中間部も n 型領域となる。即ち、窪み内領域 4 6 全体が n 型領域となる。

## 【 0 0 3 1 】

次に、半導体部 ( シリコン ) 2 2 の表面を例えば熱酸化法によって酸化する。これにより、図 4 に示すように、半導体部 2 2 の表面に沿って絶縁膜 ( シリコン酸化膜 ) 3 6 が形成される。次に、表面に絶縁膜 3 6 が形成された半導体部 2 2 上に、電極層 3 8 , 3 9 を積層する。次に、この電極層 3 8 , 3 9 をエッチングによって所定の形状にパターニングする。これにより、ゲート電極 3 8 とゲート引出し部 3 9 が形成される。次に、ゲート電極 3 8 とゲート引出し部 3 9 上に層間絶縁膜 4 2 を形成する。次に、ゲート引出し部 3 9 上の層間絶縁膜 4 2 にコンタクトホール 4 3 を形成する。次に、層間絶縁膜 4 2 上にゲート配線層 4 4 を積層する。次に、このゲート配線層 4 4 をエッチングによって所定の形状にパターニングする。次に、熱処理 ( アニール処理 ) を行う。これにより、ゲート配線層 4 4 とゲート引出し部 3 9 のコンタクト性を向上できる。また、半導体部 2 2 にイオン注入した不純物を活性化できる。

20

以上の工程を経て、第 1 実施例の半導体装置が製造される。

## 【 0 0 3 2 】

図 1 5 に示す従来の半導体装置では、p 型ボディ領域 9 3 0 よりも深い位置に n 型領域 9 2 9 を形成する必要があった。このような n 型領域 9 2 9 を形成するためには、半導体部の頂面から深い位置へのイオン注入等を行う必要があった。このため、n 型領域 9 2 9 を形成するのに手間がかかるという問題があった。

30

これに対し、第 1 実施例の半導体装置の場合、トレンチ 3 4 を形成した後、そのトレンチ 3 4 の底面から浅い位置にイオン注入することで、n 型の窪み内領域 4 6 を形成できる ( 図 8 参照 ) 。このため、n 型の窪み内領域 4 6 を形成するのは、図 1 5 の n 型領域 9 2 9 を形成するのに比べて少ない手間で済む。

## 【 0 0 3 3 】

また、第 1 実施例では、窪み内領域 4 6 に n 型不純物をイオン注入している。しかし、窪み内領域 4 6 には、n 型不純物をイオン注入しない態様も可能である。即ち、窪み内領域 4 6 が p 型であっても、窪み内領域 4 6 にホールを溜める効果が得られる。この場合、窪み内領域 4 6 に n 型不純物をイオン注入する手間が省ける。よって、図 1 5 の n 型領域 9 2 9 を形成する場合に比べて、より製造工程を簡単化できる。

40

## 【 0 0 3 4 】

次に、第 1 実施例の半導体装置の第 2 製造方法について説明する。なお、第 1 製造方法と共通する部分については説明を省略する。

第 2 製造方法では、図 9 に示すように、半導体部 2 2 のうち、トレンチを形成しない領域上に第 1 マスク 5 2 を形成する。次に、図 1 0 に示すように、第 1 マスク 5 2 で覆われていない半導体部 2 2 を R I E 等によって所定深さまでエッチングする。これにより、浅い

50

トレンチをまず形成する。次に、その浅いトレンチ底面に隣接する半導体部 22 のうち、深いトレンチを形成しない領域上に第 2 マスク 53 を形成する。次に、図 11 に示すように、第 1 マスク 52 と第 2 マスク 53 で覆われていない半導体部 22 を R I E 等によって所定深さまでエッチングする。なお、第 1 マスク 52 と第 2 マスク 53 は、エッチングの際に使用するエッチャントに対してほとんどエッチングされない材料を用いることが好ましい。これにより、半導体部 22 には、第 1 製造方法の場合と同様に、底面が窪んだトレンチ 34 が形成される。

【0035】

図 12 は、第 2 実施例の半導体装置について図 1 の C - C 線断面図に対応する図を示す。第 2 実施例においても、トレンチ 34 の底面は、トレンチ 34 側に窪んでいる。第 2 実施例の場合、トレンチ 34 の底面は段差状に窪んでいる。半導体部 22 は、その窪み内に位置する領域（窪み内領域）56 を有する。窪み内領域 56 の頂面と 1 つの側面は、ゲート絶縁膜 36 によって覆われている。この側面は、トレンチ 34 の幅方向に伸びている。

10

【0036】

第 2 実施例によっても、オン時にはこの窪み内領域 56 にホールを溜めることができる。よって、オン電圧を低減できる。

【0037】

図 13 は、第 3 実施例の半導体装置について図 1 の A - A 線断面図に対応する図を示す。第 3 実施例においても、トレンチ 34 の底面は、トレンチ 34 側に窪んでいる。半導体部 22 は、その窪み内に位置する領域（窪み内領域）58 を有する。この窪み内領域 58 は、トレンチ 34 の奥行方向（図 13 の紙面垂直方向）に沿って伸びている。この窪み内領域 58 の頂面と 2 つの側面は、ゲート絶縁膜 36 によって覆われている。これら 2 つの側面は、トレンチ 34 の奥行方向に伸びている

20

【0038】

第 3 実施例によっても、オン時にはこの窪み内領域 58 にホールを溜めることができる。よって、オン電圧を低減できる。

【0039】

図 14 は、第 4 実施例の半導体装置のトレンチ 34 付近の模式図を示す。第 4 実施例においても、トレンチ 34 の底面は、トレンチ 34 側に窪んでいる。半導体部 22 は、その窪み内に位置する領域（窪み内領域）60 を複数有する。各窪み内領域 60 は、頂面と全ての側面（4 つの側面）がゲート絶縁膜 36 で覆われている。なお、図 14 では、ゲート絶縁膜 36 を模式的に斜線によって示している。

30

【0040】

第 4 実施例では、窪み内領域 60 は、頂面と全ての側面がゲート絶縁膜 36 で覆われている。よって、オン時には窪み内領域 60 にホールをより溜め易くすることができる。このため、オン抵抗をより低減し得る。

【0041】

以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。

40

また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。

【図面の簡単な説明】

【図 1】第 1 実施例の半導体装置の平面図の一部を示す。

【図 2】図 1 の A - A 線断面図を示す。

【図 3】図 1 の B - B 線断面図を示す。

【図 4】図 1 の C - C 線断面図を示す。

【図 5】第 1 実施例の半導体装置の第 1 製造方法の説明図を示す（1）。

50



- 【図 6】第 1 実施例の半導体装置の第 1 製造方法の説明図を示す ( 2 )。  
【図 7】第 1 実施例の半導体装置の第 1 製造方法の説明図を示す ( 3 )。  
【図 8】第 1 実施例の半導体装置の第 1 製造方法の説明図を示す ( 4 )。  
【図 9】第 1 実施例の半導体装置の第 2 製造方法の説明図を示す ( 1 )。  
【図 10】第 1 実施例の半導体装置の第 2 製造方法の説明図を示す ( 2 )。  
【図 11】第 1 実施例の半導体装置の第 2 製造方法の説明図を示す ( 3 )。  
【図 12】第 2 実施例の半導体装置について図 1 の C - C 線断面図に対応する図を示す。  
【図 13】第 3 実施例の半導体装置について図 1 の A - A 線断面図に対応する図を示す。  
【図 14】第 4 実施例の半導体装置のトレンチ付近の模式図を示す。  
【図 15】従来 of 半導体装置の断面図を示す。

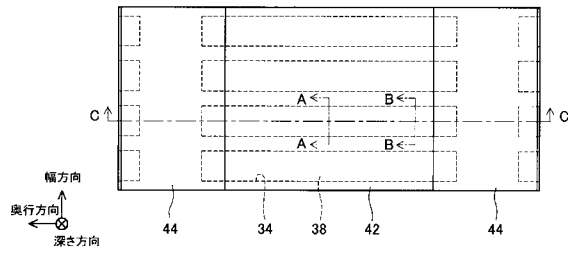
10

【符号の説明】

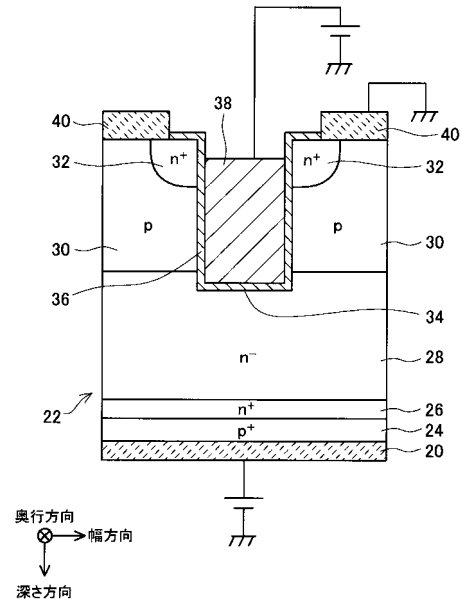
- 20 : コレクタ電極  
22 : 半導体部  
24 : p<sup>+</sup>型コレクタ領域  
26 : n<sup>+</sup>型バッファ領域  
28 : n<sup>-</sup>型ドリフト領域  
30 : p型ボディ領域  
32 : n<sup>+</sup>型エミッタ領域  
34 : トレンチ  
36 : ゲート絶縁膜  
38 : ゲート電極  
39 : ゲート引出し部  
40 : エミッタ電極  
42 : 層間絶縁膜  
44 : ゲート配線層  
46 : 窪み内領域

20

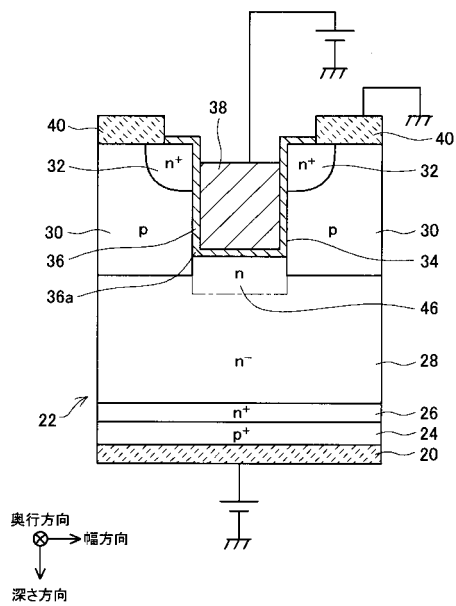
【図 1】



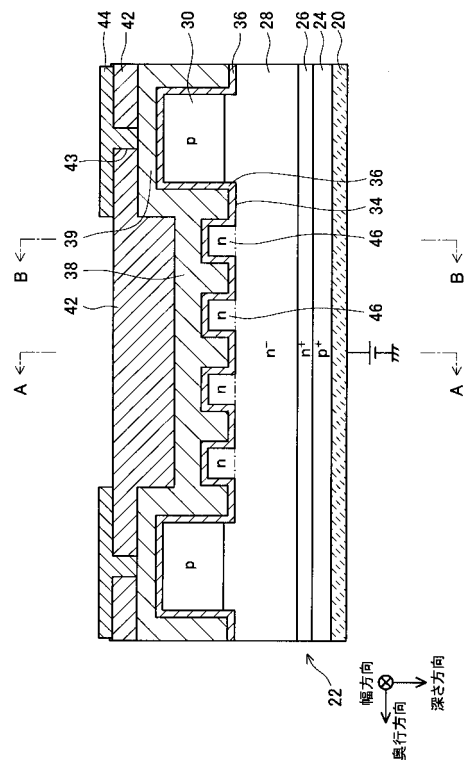
【図 2】



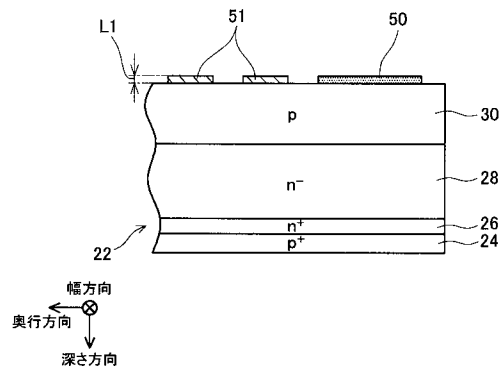
【図 3】



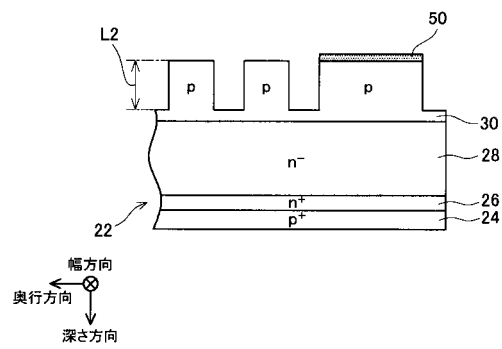
【図 4】



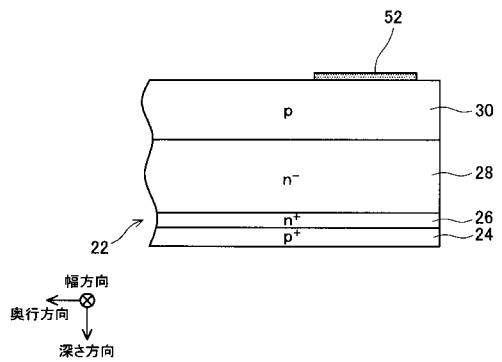
【図 5】



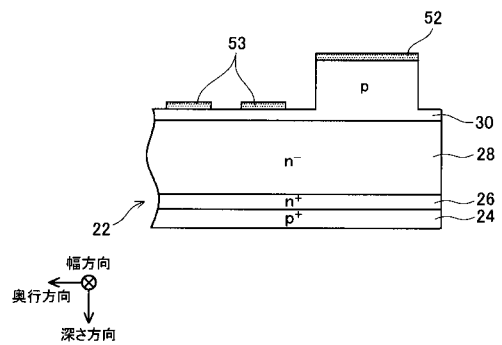
【図 6】



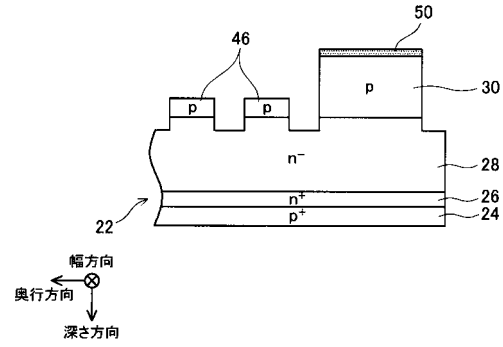
【図 9】



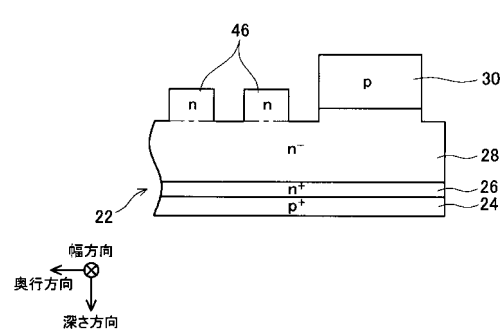
【図 10】



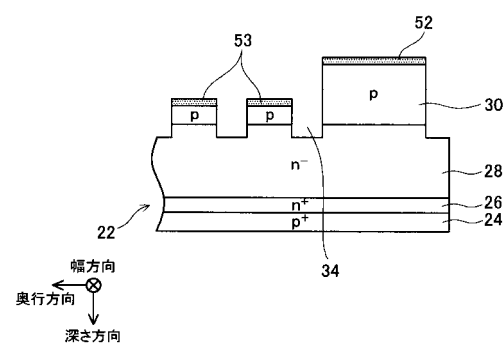
【図 7】



【図 8】



【図 11】





---

フロントページの続き

(72)発明者 植田 賢志  
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

審査官 小野田 誠

(56)参考文献 特開平10-261624(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 29/78

H01L 29/739